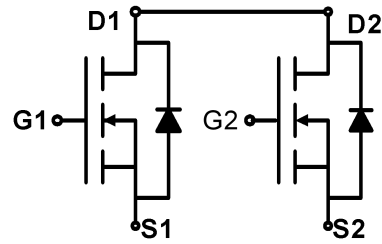




描述

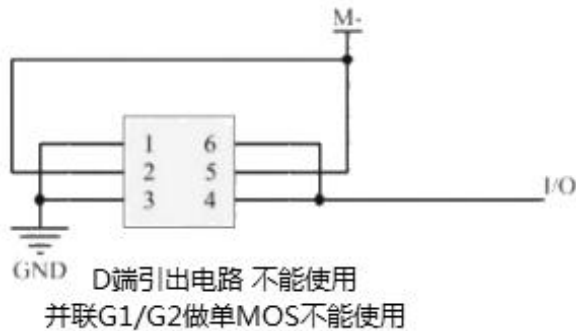
- 20V MOSFET 技术
- 极低的导通电阻
- 超快的开关速度
- Drain(2、5 脚内部连接金属线连接)。
- $V_{gs} \pm 8V$



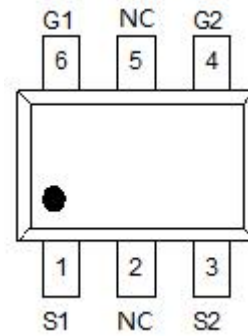
电路结构图

应用

- 用于单节锂电池保护（仅限于锂电池保护板使用）
- 不适用电路如（图一），不可当 10mohm MOSFET 并联使用！
- 封装形式：SOT23-6



(图一)



8205C/SOT23-6

((D1/D2 Pin2 和 Pin5 不连出))

订购信息

工作温度范围 (结温)	封装		型号	包装数量
-55° C ~ +150° C	SOT23-6	Pb-Free	8205C	3000 片/盘

备注： (2、5 脚内部金属线连接)。



最大额定值

参数	符号	值	单位
漏源电压	VBDSB	20	V
栅源电压	VBGSB	±8	V
漏极电流, VBGS B=4.5V, @TBaB=25° C	IBD B	6	A
漏极电流, VBGS B=4.5V, @TBaB=70° C	IBD B	4.8	A
漏极脉冲电流 (注 1)	IBDMB	20	A
工作结温	TBjB	-55 ~ +150	° C
存储温度	TBstgB	-55 ~ +150	° C

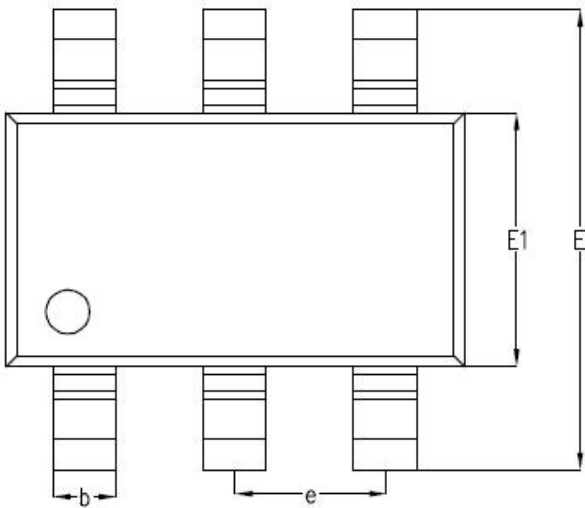
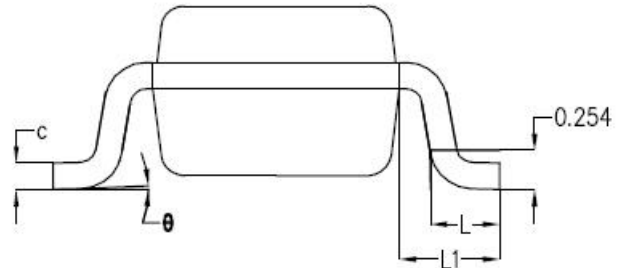
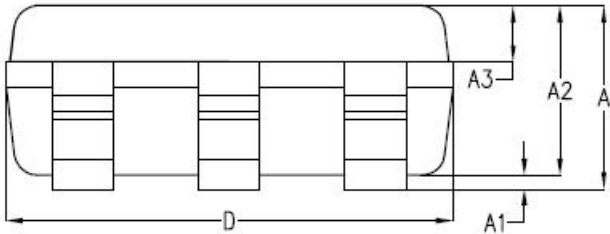
电气特性(Ta = 25°C, 除非另有说明。)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	BVBDSSB	VBGS B= 0, IBD B= 250μA	19.5	20.5		V
漏源漏电流	IBDSSB	VBDSB = 16V, VBGS B= 0	-	-	1	μA
栅源漏电流	IBGSSB	VBGSB = ±6V, VBDSB = 0	-	-	±1	uA
击穿电压温度系数	$\Delta BVBDSS / \Delta TBjB$	参考点 25° C IBDB = 1mA	-	0.03	-	V/° C
栅极门限电压	VBGS(th)B	VBDSB = VBGSB, IBD B= 250μA	0.4	0.65	1.0	V
漏源导通电阻	RBSS(ON)B	VBGSB = 4.5V, IBD B= 6A	-	39	54	mΩ
		VGS=3.8V, IBD B= 3A		45	58	mΩ
		VBGSB = 2.5V, IBD B= 3.0A	-	52	68	mΩ
正向跨导	gBfsB	VBDSB = 5V, IBD B= 4.5A	-	10	-	S
源漏正向导通电压	VBSD B	IBSB=1.0A, VBGSB=0V TBjB=25° C	-	0.72	1.2	V



封装信息

➤ SOT23-6



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	-	1.19	1.24
A1	-	0.05	0.09
A2	1.05	1.10	1.15
A3	0.31	0.36	0.41
b	0.35	0.40	0.45
c	0.12	0.17	0.22
D	2.85	2.90	2.95
E	2.80	2.90	3.00
E1	1.55	1.60	1.65
e	0.95BSC		
L	0.37	0.45	0.53
L1	0.65BSC		
θ	0°	2°	8°